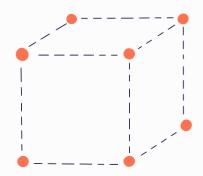
## FISICA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

## Conduzione nei solidi



I solidi, dal punto di vista microscopico, sono fatti come dei reticoli dove, ai vertici, abbiamo degli ioni legati tra di loro i quanto condividono degli elettroni.

Il comportamento degli elettroni all'interno del reticolo è descritto dalla meccanica quantistica come se fossero delle *onde* (dualismo ondaparticella) con le seguenti caratteristiche:

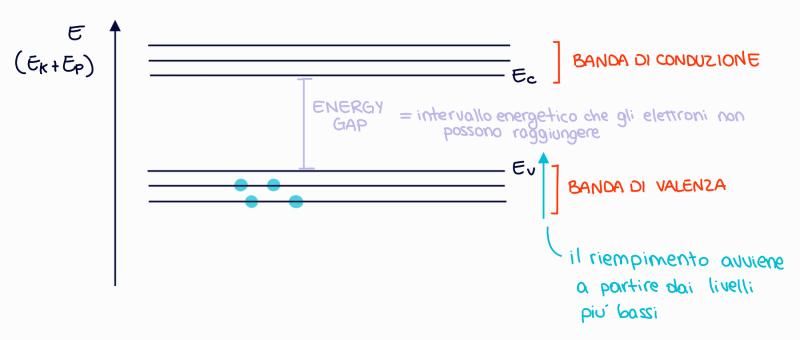
- non tutte le onde sono permesse;
- a ciascuna onda è associato un livello di energia.

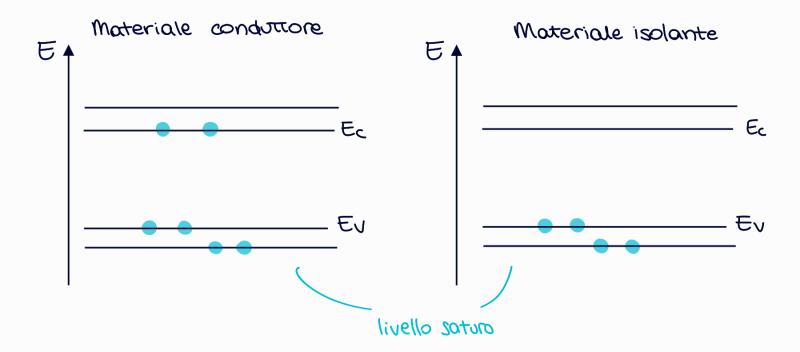
Questi livelli di energia sono raggruppati in bande.

## Principio di esclusione di Pauli

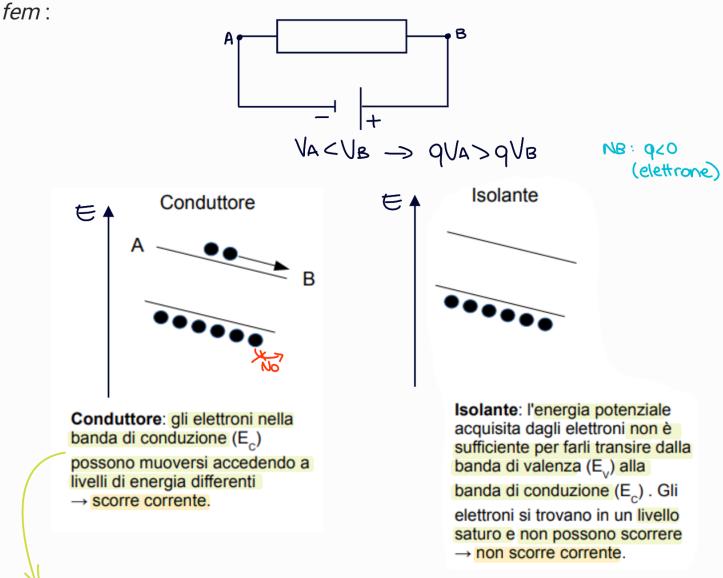
In ciascuno dei livelli non possono esserci più di due elettroni: poiché in un solido ci sono moltissimi elettroni, questi tenderanno a occupare livelli distinti.

Dal punto di vista energetico:





Supponiamo di collegare le estremità di un campione di materiale ad una



perdendo energia potenziale e acquistando energia cinetica.

Nei materiali semiconduttori c'è una situazione intermedia:



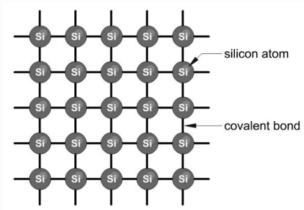
Nei semiconduttori neanche la banda di valenza è satura (lacuna = mancanza di una carica negativa), quindi sia gli elettroni sia le lacune sono liberi di muoversi.

Di conseguenza scorre una corrente dovuta sia al moto degli elettroni sia al moto delle lacune.

## Semiconduttori drogati

Il principale semiconduttore utilizzato nei dispositivi elettronici è il silicio (Si).

In condizioni normali il silicio ha 4 elettroni di valenza è si comporta come un isolante.



È possibile introdurre all'interno del reticolo atomi di altri elementi chiamati *droganti* o *impurità*. Questo processo prende il nome di *dragaggio*.

- Dragaggio di tipo n: utilizzo elementi del V gruppo (come ad esempio il fosforo)
- Dragaggio di tipo p: utilizzo elementi del III gruppo (come ad esempio il boro)

